

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-117058

(P2001-117058A)

(43) 公開日 平成13年4月27日 (2001.4.27)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マ-ト* (参考)
G 0 2 F 1/025		G 0 2 F 1/025	2 H 0 4 7
G 0 2 B 6/12		H 0 1 S 5/22	2 H 0 7 9
// H 0 1 S 5/22		G 0 2 B 6/12	J 5 F 0 7 3

審査請求 未請求 請求項の数19 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号 特願平11-291890

(22) 出願日 平成11年10月14日 (1999. 10. 14)

(71) 出願人 000000295

沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

(72) 発明者 山田 光志

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気
工業株式会社内

(74) 代理人 100083840

弁理士 前田 実

Fターム(参考) 2H047 KA04 KA13 KA15 NA04 QA02

RA08

2H079 AA02 AA13 BA01 CA05 DA16

EA02 EA03 EA07 EA22 EA27

EA28

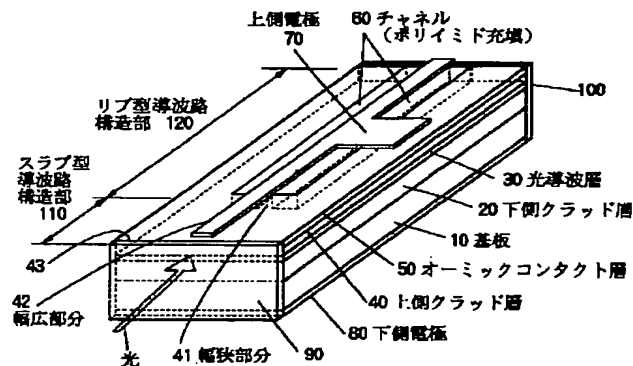
5F073 AA22 AA89 CB11

(54) 【発明の名称】 半導体導波路素子及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 許容入力光パワーの大きい半導体導波路素子を提供する。

【解決手段】 下側クラッド層20と、上側クラッド層40と、これらに挟まれた光導波層30と、下側電極80及び上側電極70とを有し、光導波層30の端面から光を入射させる半導体導波路素子であって、上側クラッド層40が、ストライプ状の幅狭部分41と、この幅狭部分41よりも光が入射される端面に近い位置に形成されており、幅狭部分41よりも広い幅を持つ幅広部分42とを有する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 下側クラッド層と、
上側クラッド層と、
上記下側クラッド層と上記上側クラッド層とに挟まれた
光導波層と、
上記下側クラッド層、上記光導波層、及び上記上側クラ
ッド層を含む積層構造に電圧を印加する下側電極及び上
側電極と、
を有し、上記光導波層の端面から光を入射させる半導体
導波路素子において、
上記上側クラッド層が、
ストライプ状の幅狭部分と、
上記幅狭部分よりも光が入射される端面に近い位置に形
成されており、上記幅狭部分よりも広い幅を持つ幅広部
分と、
を有することを特徴とする半導体導波路素子。

【請求項 2】 上記上側クラッド層の幅広部分と、上記
下側クラッド層及び上記光導波層の幅広部分に重なる
部分とがスラブ型導波路構造を形成することを特徴と
する請求項 1 記載の半導体導波路素子。

【請求項 3】 上記上側クラッド層の幅広部分は、光が
入射される上記端面に近づくにつれて幅が広くなること
を特徴とする請求項 1 記載の半導体導波路素子。

【請求項 4】 上記上側クラッド層の両側にそれぞれ、
チャンネルが形成されていることを特徴する請求項 1 から
3 までのいずれか一つに記載の半導体導波路素子。

【請求項 5】 上記チャンネルの幅が、光が入射される上
記端面に近づくにつれて狭くなることを特徴する請求項
4 記載の半導体導波路素子。

【請求項 6】 上記光導波層が上記上側クラッド層と同
じ幅を持つことを特徴とする請求項 1 から 5 までのい
ずれか一つに記載の半導体導波路素子。

【請求項 7】 上記上側電極が、上記上側クラッド層の
幅狭部分上から幅広部分上まで延びていることを特徴と
する請求項 1 から 6 までのいずれか一つに記載の半導体
導波路素子。

【請求項 8】 下側クラッド層と、
上側クラッド層と、
上記下側クラッド層と上記上側クラッド層とに挟まれた
光導波層と、
上記下側クラッド層、上記光導波層、及び上記上側クラ
ッド層を含む積層構造に電圧を印加する下側電極及び上
側電極と、
を有し、上記光導波層の端面から光を入射させる半導体
導波路素子において、
上記上側クラッド層と上記光導波層とが上記下側クラ
ッド層より幅の狭いストライプ状であり、
上記上側クラッド層と上記光導波層との側面に接し、少
なくとも不純物キャリア濃度が $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 以下の
半導体材料からなる半導体積層体を設けたことを特徴と

する半導体導波路素子。

【請求項 9】 上記半導体積層体が、上記光導波層を構
成する半導体材料と格子整合の関係にある半導体材料か
らなることを特徴とする請求項 8 記載の半導体導波路素
子。

【請求項 10】 上記半導体積層体上の、光が入射され
る上記端面の近傍に金属部材を備えたことを特徴とする
請求項 8 又は 9 のいずれか一つに記載の半導体導波路素
子。

【請求項 11】 下側クラッド層と、
上側クラッド層と、
上記下側クラッド層と上記上側クラッド層とに挟まれた
光導波層と、
上記下側クラッド層、上記光導波層、及び上記上側クラ
ッド層を含む積層構造に電圧を印加する下側電極及び上
側電極と、
を有し、上記光導波層の端面から光を入射させる半導体
導波路素子において、
光が入射される上記端面の近傍に金属部材を備えたこと
を特徴とする半導体導波路素子。

【請求項 12】 上記上側クラッド層が上記光導波層を
露出させるチャンネルを有し、
上記金属部材が、上記チャンネル内の上記光導波層上に備
えられたことを特徴とする請求項 11 記載の半導体導波
路素子。

【請求項 13】 下側クラッド層と、
上側クラッド層と、
上記下側クラッド層と上記上側クラッド層とに挟まれた
光導波層と、
上記上側クラッド層の一部をストライプ状に残すよう
に、上記ストライプ状の部分の両脇にそれぞれ形成され
たチャンネルと、
上記下側クラッド層、上記光導波層、及び上記上側クラ
ッド層を含む積層構造に電圧を印加する下側電極及び上
側電極と、
を有し、上記光導波層の端面から光を入射させる半導体
導波路素子において、
上記チャンネルの深さが、光が入射される端面に近づくほ
ど浅くなるように上記上側クラッド層を形成したことを
特徴とする半導体導波路素子。

【請求項 14】 上記チャンネルの端部が、光が入射され
る上記端面まで達するように形成されていることを特徴
する請求項 4, 5, 13 のいずれか一つに記載の半導体
導波路素子。

【請求項 15】 上記チャンネルの端部が、光が入射され
る上記端面までたっしていないように形成されているこ
とを特徴する請求項 4, 5, 13 のいずれか一つに記載
の半導体導波路素子。

【請求項 16】 単一の基板と、
上記基板上に形成された半導体レーザ部及び半導体光機

能部と、

を有する半導体導波路素子において、
上記半導体光機能部が、上記請求項1から14までのいずれか一つに記載の半導体導波路素子からなることを特徴とする半導体導波路素子。

【請求項17】 単一の基板と、
上記基板上に形成されたレーザ光の振幅の変調部及び半導体光機能部と、
を有する半導体導波路素子において、
上記半導体光機能部が、上記請求項1から14までのいずれか一つに記載の半導体導波路素子からなることを特徴とする半導体導波路素子。

【請求項18】 基板上に、下側クラッド層、光導波路層、及び第一の上側クラッド層を順に堆積させる工程と、
上記第一の上側クラッド層に幅広の露出部と幅狭の露出部とが形成されるように、上記第一の上側クラッド層上に第一のマスクを形成する工程と、
上記第一のマスク及び上記第一の上側クラッド層を覆うように第二の上側クラッド層を形成する工程と、
上記第二の上側クラッド層上に、チャンネル形成部分に開口部を備えた第二のマスクを形成する工程と、
ドライエッチングにより第二のマスクの開口部にある上記第二の上側クラッド層を除去する工程と、
を有することを特徴とする半導体導波路素子の製造方法。

【請求項19】 基板上に、下側クラッド層、光導波路層、及び上側クラッド層を順に堆積させる工程と、
上記上側クラッド層上に、チャンネル形成部分に開口部を備えたマスクを形成する工程と、
上記マスクの開口部上に逆メサ構造の遮蔽体と置く工程と、
ドライエッチングによりマスクの開口部にある上記第二の上側クラッド層を除去する工程と、
を有することを特徴とする半導体導波路素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば、電界吸収型光強度変調器（EA変調器）や過飽和吸収素子（SA素子）等の半導体導波路素子及びその製造方法に関し、特に、入力光が入射する端面付近の構造に関するものである。

【0002】

【従来の技術】EA変調器は、電気－光変換器としてだけでなく、光ゲートや、光－光スイッチ等の様々な用途への応用が検討されている。このため、EA変調器への許容入力光パワーの増大の要求が強まると予想される。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、EA変調器において入力光パワー又は逆方向電圧を大きくしていくと、光入力端面付近のコア層において大きなフォトリソントが発生し、この端面付近の温度が半導体材料の融点に達して素子が破壊されるという問題があった。

【0004】特に、チャンネル構造を持つリブ型（又はリッジ型）導波路素子の場合には、隆起部分の両側が空気又はポリイミド充填層であるので、フォトリソントによって発生した熱が放熱されにくく、許容入力光パワーが低いという問題があった。

【0005】そこで、本発明は上記したような従来技術の課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、許容入力光パワーの大きい半導体導波路素子及びその製造方法を提供することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】請求項1の半導体導波路素子は、下側クラッド層と、上側クラッド層と、上記下側クラッド層と上記上側クラッド層とに挟まれた光導波層と、上記下側クラッド層、上記光導波層、及び上記上側クラッド層を含む積層構造に電圧を印加する下側電極及び上側電極とを有し、上記光導波層の端面から光を入射させるものであって、上記上側クラッド層が、ストライプ状の幅狭部分と、上記幅狭部分よりも光が入射される端面に近い位置に形成されており、上記幅狭部分よりも広い幅を持つ幅広部分とを有することを特徴としている。

【0007】また、請求項2の半導体導波路素子は、上記上側クラッド層の幅広部分と、上記下側クラッド層及び上記光導波層の上記幅広部分に重なる部分とがスラブ型導波路構造を形成することを特徴としている。

【0008】また、請求項3の半導体導波路素子は、上記上側クラッド層の幅広部分は、光が入射される上記端面に近づくにつれて幅が広くなることを特徴としている。

【0009】また、請求項4の半導体導波路素子は、上記上側クラッド層の両側にそれぞれ、チャンネルが形成されていることを特徴している。

【0010】また、請求項5の半導体導波路素子は、上記チャンネルの幅が、光が入射される上記端面に近づくにつれて狭くなることを特徴している。

【0011】また、請求項6の半導体導波路素子は、上記光導波層が上記上側クラッド層と同じ幅を持つことを特徴としている。

【0012】また、請求項7の半導体導波路素子は、上記上側電極が、上記上側クラッド層の幅狭部分上から幅広部分上まで延びていることを特徴としている。

【0013】また、請求項8の半導体導波路素子は、下側クラッド層と、上側クラッド層と、上記下側クラッド層と上記上側クラッド層とに挟まれた光導波層と、上記下側クラッド層、上記光導波層、及び上記上側クラッド

層を含む積層構造に電圧を印加する下側電極及び上側電極とを有し、上記光導波層の端面から光を入射させるものであって、上記上側クラッド層と上記光導波層とが上記下側クラッド層より幅の狭いストライプ状であり、上記上側クラッド層と上記光導波層との側面に接し、少なくとも不純物キャリア濃度が $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 以下の半導体材料からなる半導体積層体を設けたことを特徴としている。

【0014】また、請求項9の半導体導波路素子は、上記半導体積層体が、上記光導波層を構成する半導体材料と格子整合の関係にある半導体材料からなることを特徴としている。

【0015】また、請求項10の半導体導波路素子は、上記半導体積層体上の、光が入射される上記端面の近傍に金属部材を備えたことを特徴としている。

【0016】また、請求項11の半導体導波路素子は、下側クラッド層と、上側クラッド層と、上記下側クラッド層と上記上側クラッド層とに挟まれた光導波層と、上記下側クラッド層、上記光導波層、及び上記上側クラッド層を含む積層構造に電圧を印加する下側電極及び上側電極とを有し、上記光導波層の端面から光を入射させるものであって、光が入射される上記端面の近傍に金属部材を備えたことを特徴としている。

【0017】また、請求項12の半導体導波路素子は、上記上側クラッド層が上記光導波層を露出させるチャンネルを有し、上記金属部材が、上記チャンネル内の上記光導波層上に備えられたことを特徴としている。

【0018】また、請求項13の半導体導波路素子は、下側クラッド層と、上側クラッド層と、上記下側クラッド層と上記上側クラッド層とに挟まれた光導波層と、上記上側クラッド層の一部をストライプ状に残すように、上記ストライプ状の部分の両脇にそれぞれ形成されたチャンネルと、上記下側クラッド層、上記光導波層、及び上記上側クラッド層を含む積層構造に電圧を印加する下側電極及び上側電極とを有し、上記光導波層の端面から光を入射させるものであって、上記チャンネルの深さが、光が入射される端面に近づくほど浅くなるように上記上側クラッド層を形成したことを特徴としている。

【0019】また、請求項14の半導体導波路素子は、上記チャンネルの端部が、光が入射される上記端面まで達するように形成されていることを特徴している。

【0020】また、請求項15の半導体導波路素子は、上記チャンネルの端部が、光が入射される上記端面まで達していないように形成されていることを特徴している。

【0021】また、請求項16の半導体導波路素子は、単一の基板と、上記基板上に形成された半導体レーザ部及び半導体光機能部とを有する素子であって、上記半導体光機能部が、上記請求項1から14までのいずれか一つに記載の半導体導波路素子からなることを特徴として

いる。

【0022】また、請求項17の半導体導波路素子は、単一の基板と、上記基板上に形成されたレーザ光の振幅の変調部及び半導体光機能部とを有する素子であって、上記半導体光機能部が、上記請求項1から14までのいずれか一つに記載の半導体導波路素子からなることを特徴としている。

【0023】また、請求項18の半導体導波路素子の製造方法は、基板上に、下側クラッド層、光導波路層、及び第一の上側クラッド層を順に堆積させる工程と、上記第一の上側クラッド層に幅広の露出部と幅狭の露出部とが形成されるように、上記第一の上側クラッド層上に第一のマスクを形成する工程と、上記第一のマスク及び上記第一の上側クラッド層を覆うように第二の上側クラッド層を形成する工程と、上記第二の上側クラッド層上に、チャンネル形成部分に開口部を備えた第二のマスクを形成する工程と、ドライエッチングにより第二のマスクの開口部にある上記第二の上側クラッド層を除去する工程とを有することを特徴としている。

【0024】また、請求項19の半導体導波路素子の製造方法は、基板上に、下側クラッド層、光導波路層、及び上側クラッド層を順に堆積させる工程と、上記上側クラッド層上に、チャンネル形成部分に開口部を備えたマスクを形成する工程と、上記マスクの開口部に逆メサ構造の遮蔽体と置く工程と、ドライエッチングによりマスクの開口部にある上記第二の上側クラッド層を除去する工程とを有することを特徴としている。

【0025】

【発明の実施の形態】実施の形態1

図1は、本発明の実施の形態1に係る半導体導波路素子の構成を概略的に示す斜視図である。また、図2は、図1の平面図（電極を除く）、図3は、図2の S_3-S_3 線断面図、図4は、図2の S_4-S_4 線断面図である。

【0026】図1に示されるように、実施の形態1の半導体導波路素子は、一方の導波路端面側がスラブ型導波路構造部110を成しており、他方の導波路端面側がスラブ型導波路構造部110と一体に形成されたリブ（リッジ）型導波路構造部120を成している。実施の形態1の半導体導波路素子は、例えば、EA変調器やSA素子であるが、これらに限定されない。

【0027】実施の形態1の半導体導波路素子は、第一導電型半導体からなる基板10と、この基板10上に備えられた第一導電型半導体からなる下側クラッド層20と、この下側クラッド層20上に備えられた光導波層30と、この光導波層（活性層又はコア層）30上に備えられた第二導電型半導体（即ち、第一導電型と異なる導電型）からなる上側クラッド層40と、この上側クラッド層40上に備えられたオーミックコンタクト層50とを有する。実施の形態1においては、基板10は $n^+-\text{InP}$ からなり、下側クラッド層20は $n-\text{InP}$ から

なり、光導波層30はundoped（不純物注入処理を施されていない）-InGaAsPからなり、上側クラッド層40はp-InPからなり、オーミックコンタクト層50は、 p^+ -InGaAsからなる。但し、各層の材料は、上記のものに限定されない。

【0028】上記積層構造により、垂直方向の光閉じ込め構造が、半導体導波路素子の全長さに渡って形成されている。そして、長さが $10\mu\text{m}$ ～ $20\mu\text{m}$ 程度のスラブ型導波路構造部110に隣接して、リブ型導波路構造部120が形成されている。

【0029】上側クラッド層40は、ストライプ状の隆起構造である幅狭部分41と、この幅狭部分41よりも光が入射される端面43に近い位置に形成されており、幅狭部分41よりも広い幅を持つ幅広部分42とを有する。ストライプ状の幅狭部分41の両脇にはチャンネル60が形成されている。実施の形態1においては、チャンネル60は、図3に示されるように、光導波層30を露出させる深さを持つ。また、チャンネル60には、例えば、ポリイミドが充填されている。

【0030】また、実施の形態1の半導体導波路素子は、オーミックコンタクト層50の上に備えられた第二導電型の上側電極70と、基板10の下側に備えられた第一導電型の下側電極80とを有している。尚、上側電極70は、スラブ型導波路構造部110上にも形成されている。また、光が入出力する端面上には無反射膜（AR膜）90及び100が形成されている。

【0031】実施の形態1の半導体導波路素子においては、スラブ型導波路構造部110側の端面から光の入力を行う。スラブ型導波路構造部110に入力した光は、上側電極70及び下側電極80により光導波層30に電界が印加されている場合には、電界吸収効果により光吸収を受け、フォトキャリアが発生してフォトカレントが流れる。このとき、光導波路30の熱抵抗により、光導波路30自体の温度が上昇する。しかし、実施の形態1のスラブ型導波路構造部110では、両脇にチャンネル60が形成されは幅狭部分41とは異なり、光導波路30で発生した熱が光導波層30及び上側クラッド層40を通して横方向に効率的に放散される。従って、実施の形態1の半導体導波路素子によれば、スラブ型導波路構造部110を持たない素子に比べ、許容入力光パワーを向上させることができる。

【0032】図5は、スラブ型導波路構造部（スラブ領域）110の長さ $[\mu\text{m}]$ と、素子が破壊される直前の破壊パワー（フォトカレントと印加電圧の積） $[\text{mW}]$ との関係の実験結果を示す図である。ここでは、スラブ型導波路構造部110に入射する光のパワーを 30mW に固定し、波長 $1.535\mu\text{m}$ の光を用い、光導波層30に印加される電圧を変化させることによって破壊パワーを測定した。図5に示される実験結果から、スラブ領域の長さを $10\mu\text{m}$ 以上にすれば、破壊レベルが2倍以上

上に改善されることが判明した。

【0033】また、実施の形態1の半導体導波路素子を構成する半導体材料の結晶成長工程は1回で済むために、製造プロセスが複雑ではなく、素子の低コスト化が実現できる。

【0034】また、図6は、本発明の実施の形態1に係る半導体導波路素子の変形例の構成を概略的に示す斜視図である。図7は、図6の S_7-S_7 線断面図、図8は、図6の S_8-S_8 線断面図である。図6から図8までに示されるように、この変形例の半導体導波路素子においては、光導波層30及び下側クラッド層20の上側の一部が、上側クラッド層40の幅狭部分41と同じ幅を持つように、図1の場合より、チャンネル60（ポリイミド充填部）が深く形成されている。上記以外の点については、図6から図8までに示される変形例は、上記図1から図5までに示される例と同一である。

【0035】実施の形態2

図9は、本発明の実施の形態2に係る半導体導波路素子の構成を概略的に示す斜視図である。また、図10は、図9の平面図（電極を除く）である。これらの図に示されるように、実施の形態2の半導体導波路素子においては、チャンネル60が、光入射端面43まで延びている点、及び、上側クラッド層40の幅広部分44の幅が、光が入射される端面43に近づくにつれて広くなるようにテーパ状に形成した点が上記実施の形態1の場合と相違する。

【0036】実施の形態2の半導体導波路素子によれば、光導波層30で発生した熱が光導波層30及びテーパ状に形成された上側クラッド層40を通して横方向に効率的に放散されるので、上側クラッド層40に幅広部分を持たない素子に比べ、許容入力光パワーを向上させることができる。

【0037】また、上記実施の形態1の場合と同様に、実施の形態2の半導体導波路素子を構成する半導体材料の結晶成長工程は1回で済むために、製造プロセスが複雑ではなく、素子の低コスト化を達成できる。

【0038】さらに、実施の形態2の半導体導波路素子によれば、光が端面43から入力すると、導波路を伝搬して他方の端面45に到達し、ここで反射して導波路を逆行する。逆行した光は、テーパ状に形成された幅広部分44で広がり、入射端面43に当たる。ここで残留反射による反射が生じるが、この反射光は広がり角を保持したまま伝搬するので、チャンネルの外側に向けて伝搬した成分は、導波路に結合せず放射される。このため、端面45からの出力光と多重反射光との干渉が抑えられ、干渉ノイズの低減された高品質の光変調信号を出力でき、誤り率が低減され、光通信における伝送距離を拡大できる。

【0039】図11は、実施の形態2に係る半導体導波路素子の変形例の構成を概略的に示す斜視図である。ま

た、図12は、図10の平面図（電極を除く）である。これらの図に示されるように、この変形例の半導体導波路素子においては、チャンネル60が光が入射される端面43に近づくにつれて細くなっている点、及び、チャンネル60の先端が光が入射される端面43に達していない点が図9及び図10の例と相違する。

【0040】また、図13は、実施の形態2に係る半導体導波路素子の他の変形例を示す平面図（電極を除く）である。図13の例は、チャンネル60の先端が光が入射される端面43に達している点のみが図11及び図12の素子と相違する。

【0041】さらにまた、図14は、実施の形態2に係る半導体導波路素子の他の変形例を示す平面図（電極を除く）である。図14の例は、チャンネル60の先端が円弧状である点のみが図11及び図12の素子と相違する。

【0042】また、図15は、実施の形態2に係る半導体導波路素子の他の変形例を示す平面図（電極を除く）である。図15の例は、チャンネル60の先端が円弧状である点のみが図9及び図10の素子と相違する。

【0043】上記した、図11から図15までの変形例のそれぞれによっても、図9及び図10の素子と同様に、出力光と多重反射光との干渉が抑えられ、干渉ノイズの低減された高品質の光変調信号を出力でき、誤り率が低減され、伝送距離を拡大できる。

【0044】実施の形態3

図16は、本発明の実施の形態3に係る半導体導波路素子の構成を概略的に示す斜視図である。また、図17は、図16のS₁₇—S₁₇線断面図である。

【0045】図16に示されるように、実施の形態3の半導体導波路素子は、埋め込みヘテロ構造（BH構造）の素子である。この半導体導波路素子は、第一導電型半導体からなる基板310と、この基板310上に備えられた第一導電型半導体からなる下側クラッド層320と、この下側クラッド層320上に備えられた光導波層（活性層又はコア層）330と、この光導波層330上に備えられた第二導電型半導体からなる上側クラッド層340と、この上側クラッド層340上に備えられたオーミックコンタクト層350とを有する。実施の形態3においては、基板310はn⁺-InPからなり、下側クラッド層320はn-InPからなり、光導波層330はundoped-InGaAsPからなり、上側クラッド層340はp-InPからなり、オーミックコンタクト層350は、p⁺-InGaAsからなる。但し、各層の材料は、上記のものに限定されない。リブ型導波路のストライプの両脇はundoped-InP（不純物キャリア濃度が1×10¹⁷cm⁻³以下）によって埋め込まれている。ここで、埋め込み材料は、光導波層330と格子整合する関係にあるものであれば、他の半導体材料を用いてもよ

い。

【0046】また、実施の形態3の半導体導波路素子は、オーミックコンタクト層350の上に備えられた第二導電型の上側電極370と、基板310の下側に備えられた第一導電型の下側電極380を有している。また、光が入出力する端面上には無反射膜90及び100が形成されている。

【0047】実施の形態3の半導体導波路素子においては、光の入射により光導波層30で発生した熱が埋め込み材料であるundoped-InGaAsPを通して横方向に効率的に放散される。従って、実施の形態1の半導体導波路素子と同様の効果が得られる。

【0048】また、実施の形態3の半導体導波路素子を構成する半導体材料の結晶成長工程は2回必要であるが、実施の形態1の場合のようにポリイミドをチャンネルに充填する工程を省略できるので、製造プロセスは複雑にはならず、素子の低コスト化が実現できる。

【0049】また、光のモードプロファイルがほぼ円形になるように素子を設計することができるので、特に、光ファイバとの光結合の際、レンズを介さなくても高い結合効率を実現できる。

【0050】さらにまた、実施の形態3の素子によれば、実施の形態1におけるスラブ領域での過剰な電気容量の増加を無くすることができるので、高速動作が期待できる。

【0051】実施の形態4

図18は、本発明の実施の形態4に係る半導体導波路素子の構成を概略的に示す平面図（電極を除く）である。また、図19は、図18のS₁₉—S₁₉線断面図、図20は、図18のS₂₀—S₂₀線断面図である。

【0052】実施の形態4の半導体導波路素子においては、上側クラッド層340が下側クラッド層320より幅の狭いストライプ状の隆起構造を持ち、金属部材410が、上側クラッド層340側面の埋め込み層361

（実施の形態3の埋め込み層360と同じ材質からなる層）の隆起構造の両脇であって、光導波層330上に備えられている。金属部材410は、導波路自体に接続される電極350には電氣的に接触していない。金属は、一般に極めて熱伝導率が大きく、従って、光吸収電流による発熱を効率的に放散できる。また、この素子をキャリアにジャンクションダウン実装する場合（後述の図23参照）には、信号ライン電極を介した熱の放散に加えて、金属部材410を介して放熱性を向上することが可能である。

【0053】図21は、本発明の実施の形態4に係る半導体導波路素子の変形例の構成を概略的に示す斜視図である。また、図22は、図21のS₂₂—S₂₂線断面図、図23は、キャリア400の電極420及び金属部材430上に図21の素子をジャンクションダウン実装する場合の説明図である。図21から図23までに示される

変形例によっても、図18から図20までに示される例と同様の効果を得ることができる。また、信号ライン電極を介した熱の放散に加えて、キャリア上に形成されたの放熱用金属側を介して、熱の放散を更に効率的に行うことができる。さらにまた、半導体導波路素子とキャリアの密着強度を向上させることもできる。

【0054】実施の形態5

図24は、本発明の実施の形態5に係る半導体導波路素子の構成を概略的に示す斜視図である。また、図25は、図24のS25-S25線断面図である。図24及び図25において、図1から図4までに示される実施の形態1の素子の構成と同一又は対応する部分には同一の符号を付す。実施の形態5の半導体導波路素子は、チャンネル60の深さが、光が入射される端面43に近づくほど浅くなるように上側クラッド層40を形成している点及びチャンネル60の先端が光入射端面43の近傍又は光入射端面43に達する位置まで延びている点が、上記実施の形態1の素子と相違する。実施の形態5の素子によれば、上側クラッド層40による水平方向の放熱性が光入射端面43近傍で良好になるので、実施の形態1の素子と同様の効果が得られる。尚、実施の形態5において上記以外の点は、上記実施の形態1の場合と同一である。

【0055】図26から図30までは、図24の半導体導波路素子の製造方法（2個の素子を形成する場合）の一例を概略的に示すものであり、(b)は平面図であり、(a)及び(c)は断面図である。

【0056】この製造方法においては、まず、図26に示されるように、基板10上に、下側クラッド層20、光導波路層30、及び第一の上側クラッド層40aを順に堆積させる。ここで、第一の上側クラッド層40aは約0.2μm厚である。

【0057】次に、図27に示されるように、第一の上側クラッド層40aに幅広の露出部40aaと幅狭の露出部40abとが形成されるように、第一の上側クラッド層40a上に第一のマスク130を形成する。ここで、幅狭の露出部40abは、切断により、半導体導波路素子の光入射端面になる部分である。また、マスク130は、SiO₂からなる。また、マスク130の平面形状は、図27(b)のものに限定されない。マスク130の平面形状は、矩形ではなく、半導体導波路素子の光入射端面になる部分において狭くなるような曲線状の端部を有するものであってもよい。

【0058】次に、図28に示されるように、第一の上側クラッド層40aを覆うように第二の上側クラッド層40bとオーミックコンタクト層50を堆積させる。このとき、図28(a)に示されるように、半導体導波路素子の光入射端面になる部分において厚く成長する。尚、第一のマスク130の上には、結晶成長は生じない。

【0059】次に、図29に示されるように、オーミッ

クコンタクト層50上に、チャンネル形成部分に2本の開口部140aを備えた第二のマスク140を形成する。マスク140は、SiO₂からなる。

【0060】次に、第二のマスク140の開口部140aにあるオーミックコンタクト層50、第二の上側クラッド層40b及び第一の上側クラッド層40aをドライエッチングし、その後、第二のマスク140を除去する。このとき、図30(a)及び(c)に示されるように、半導体導波路素子の光入射端面になる部分において、上側クラッド層40が残存し、図30(c)に符号40cで示されるような、チャンネル底部を構成する傾斜部が形成される。

【0061】図31から図34までは、図24の半導体導波路素子の製造方法（2個の素子を形成する場合）の他の例を概略的に示すものであり、(b)は平面図であり、(a)及び(c)は断面図である。

【0062】この製造方法においては、まず、図31に示されるように、基板10上に、下側クラッド層20、光導波路層30、上側クラッド層40、及びオーミックコンタクト層50を順に堆積させる。

【0063】次に、図32に示されるように、オーミックコンタクト層50上に、チャンネル形成部分に2本の開口部150aを備えた第二のマスク150を形成する。マスク150は、SiO₂からなる。

【0064】次に、図33に示されるように、マスク150の開口部150a上であって、半導体導波路素子の光入射端面になる部分上に逆メサ構造の遮蔽体160を置く。

【0065】次に、図34に示されるように、マスク150の開口部150aにある上側クラッド層40をドライエッチングし、その後、マスク150を除去する。このとき、図34(a)及び(c)に示されるように、半導体導波路素子の光入射端面になる部分において、上側クラッド層40が残存し、図30(c)に符号40cで示されるような、チャンネル底部を構成する傾斜部が形成される。

【0066】実施の形態6

図35は、本発明の実施の形態6に係る半導体導波路素子を概略的に示す斜視図である。図35に示されるように、実施の形態6の半導体導波路素子は、単一の基板10と、この基板10上に形成された半導体レーザ部500及び半導体光機能部510とを有する。実施の形態6においては、半導体レーザ部500からのレーザ光を半導体光機能部510が変調する。半導体レーザ部500と、半導体光機能部510とは共通のチャンネル60を持ち、連結部分の上側クラッド層40が幅広になるようにチャンネル60の幅が狭くなっている。実施の形態6の半導体光機能部510は、上記実施の形態2の半導体導波路素子と同様の機能を持つので、実施の形態2と同様の効果を得ることができる。

【0067】尚、半導体レーザ500に代えて、レーザ光の振幅の増幅又は減衰部（例えば、半導体光増幅器や可変光減衰器等）を備えてもよい。また、図示の半導体機能部510に代えて、上記実施の形態1から5までの他の半導体導波路素子の構造を採用することもできる。

【0068】尚、上記した実施の形態1から6までは、基板10の結晶の面方位、あるいは、ストライプの形成方向には限定されるものではない。また、上記した実施の形態1から6までは、それぞれの領域の光導波層の形成及び成長方法には、限定されるものではない。また、上記した実施の形態1から6までの光導波層30の構造は、多重量子井戸構造であってもよい。さらにまた、上記実施の形態1から6までにおいては、一方の端面側にのみ放熱構造を形成しているが、他方の端面側に形成してもよい。また、上記実施の形態に1から6における半導体導波路素子は、EA変調器に限らず、SA素子であってもよい。

【0069】

【発明の効果】以上説明したように、請求項1から17までの発明によれば、フォトカレントに起因する発熱を効率的に放熱できるので、許容入力光パワーを向上させることができるという効果がある。

【0070】また、請求項3の発明によれば、出力光と多重反射光との干渉が抑えられ、干渉ノイズの低減された高品質の光変調信号を出力でき、誤り率が低減され、伝送距離を拡大できるという効果がある。

【0071】また、請求項18及び19の発明によれば、チャンネルの深さが、光が入射される端面に近づくほど浅くなるような上側クラッド層を簡単な工程で形成することができるので、素子の低コスト化を達成できるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施の形態1に係る半導体導波路素子の構成を概略的に示す斜視図である。

【図2】 図1の平面図（電極を除く）である。

【図3】 図2のS₃－S₃線断面図である。

【図4】 図2のS₄－S₄線断面図である。

【図5】 スラブ型導波路構造部（スラブ領域）の長さ〔μm〕と、素子が破壊される直前の破壊パワー（フォトカレントと印加電圧の積）〔mW〕との関係の実験結果を示す図である。

【図6】 実施の形態1に係る半導体導波路素子の変形例の構成を概略的に示す斜視図である。

【図7】 図6のS₇－S₇線断面図である。

【図8】 図6のS₈－S₈線断面図である。

【図9】 本発明の実施の形態2に係る半導体導波路素子の構成を概略的に示す斜視図である。

【図10】 図9の平面図（電極を除く）である。

【図11】 実施の形態2に係る半導体導波路素子の変形例の構成を概略的に示す斜視図である。

【図12】 図10の平面図（電極を除く）である。

【図13】 実施の形態2に係る半導体導波路素子の他の変形例を示す平面図（電極を除く）である。

【図14】 実施の形態2に係る半導体導波路素子の他の変形例を示す平面図（電極を除く）である。

【図15】 実施の形態2に係る半導体導波路素子の他の変形例を示す平面図（電極を除く）である。

【図16】 本発明の実施の形態3に係る半導体導波路素子の構成を概略的に示す斜視図である。

【図17】 図16のS₁₇－S₁₇線断面図である。

【図18】 本発明の実施の形態4に係る半導体導波路素子の構成を概略的に示す平面図（電極を除く）である。

【図19】 図18のS₁₉－S₁₉線断面図である。

【図20】 図18のS₂₀－S₂₀線断面図である。

【図21】 本発明の実施の形態4に係る半導体導波路素子の構成を概略的に示す斜視図である。

【図22】 図21のS₂₂－S₂₂線断面図である。

【図23】 ジャンクションダウン実装の説明図である。

【図24】 本発明の実施の形態5に係る半導体導波路素子の構成を概略的に示す斜視図である。

【図25】 図24のS₂₅－S₂₅線断面図である。

【図26】 図24の半導体導波路素子の製造方法を示す工程図（その1）であり、（a）は（b）のS₂₆－S₂₆線断面図である。

【図27】 図24の半導体導波路素子の製造方法を示す工程図（その2）であり、（a）は（b）のS₂₇－S₂₇線断面図である。

【図28】 図24の半導体導波路素子の製造方法を示す工程図（その3）であり、（a）は（b）のS₂₈－S₂₈線断面図である。

【図29】 図24の半導体導波路素子の製造方法を示す工程図（その4）であり、（a）は（b）のS₂₉－S₂₉線断面図である。

【図30】 図24の半導体導波路素子の製造方法を示す工程図（その5）であり、（a）は（b）のS_{30a}－S_{30a}線断面図、（c）は（b）のS_{30c}－S_{30c}線断面図である。

【図31】 図24の半導体導波路素子の他の製造方法を示す工程図（その1）であり、（a）は（b）のS₃₁－S₃₁線断面図である。

【図32】 図24の半導体導波路素子の他の製造方法を示す工程図（その2）であり、（a）は（b）のS₃₂－S₃₂線断面図である。

【図33】 図24の半導体導波路素子の他の製造方法を示す工程図（その3）であり、（a）は（b）のS₃₃－S₃₃線断面図である。

【図34】 図24の半導体導波路素子の他の製造方法を示す工程図（その4）であり、（a）は（b）のS

34a-S_{34a}線断面図、(c)は(b)のS_{34c}-S_{34c}線断面図である。

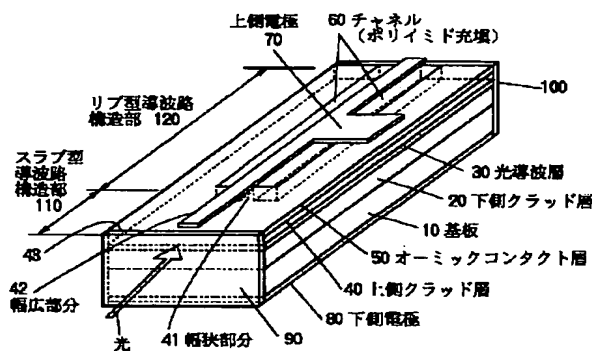
【図35】 本発明の実施の形態6に係る半導体導波路素子の構成を概略的に示す斜視図である。

【符号の説明】

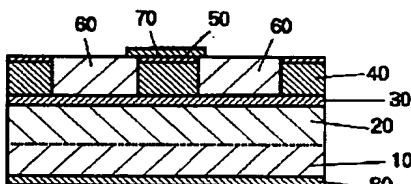
10, 310 基板、20, 320 下側クラッド層、30, 330 光導波層、40, 340 上側クラッド層、40c 傾斜部、41 幅狭部分、42, 44 幅広部分、43 端面、50 オーミックコンタクト層、60 チャンネル(ポリイミド充填)

填)、70, 370 上側電極、80, 380 下側電極、90, 100 無反射膜、110 スラブ型導波路構造部、120 リブ型導波路構造部、130, 140, 150 マスク、140a, 150a 開口部、160 遮蔽体、350 オーミックコンタクト層、360, 361 埋め込み層、400 キャリア、410, 430 金属部材、420 電極、500 半導体レーザ部、510 半導体光機能部。

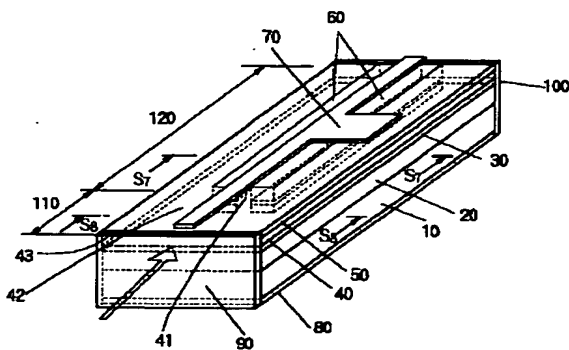
【図1】



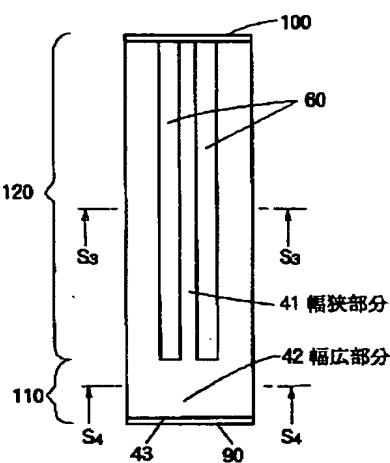
【図3】



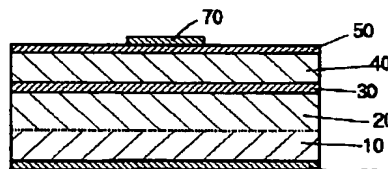
【図6】



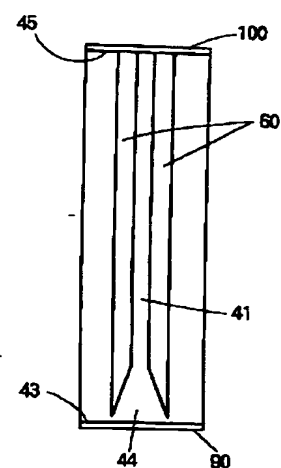
【図2】



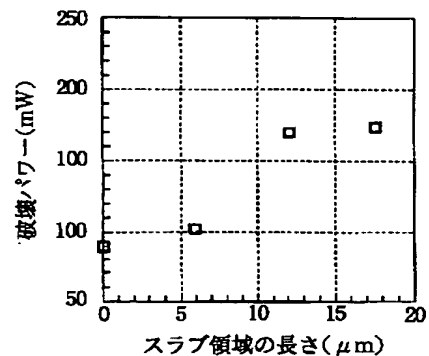
【図4】



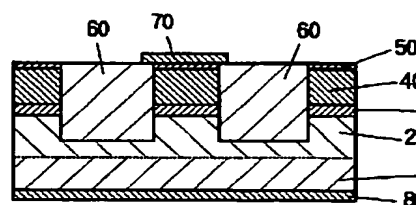
【図12】



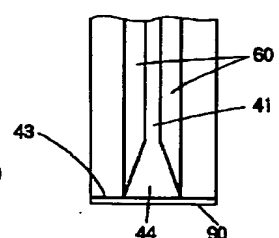
【図5】



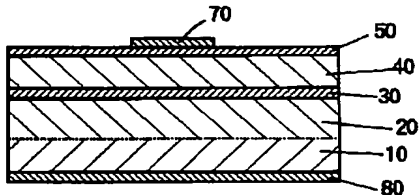
【図7】



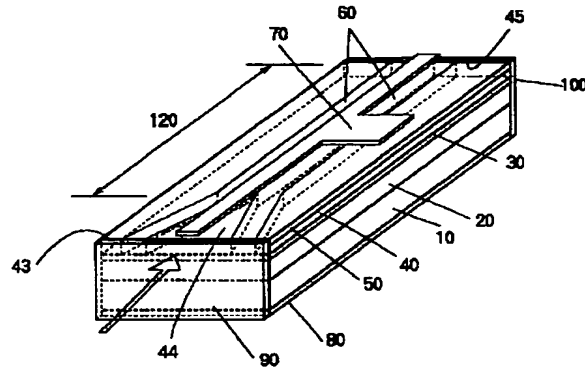
【図13】



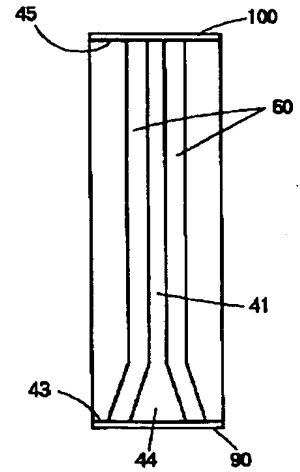
【図 8】



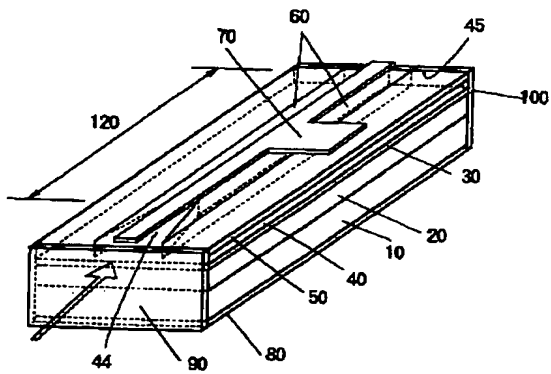
【図 9】



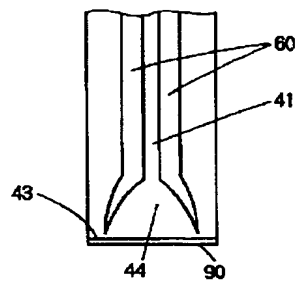
【図 10】



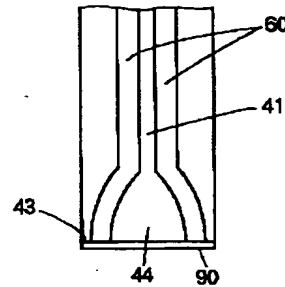
【図 11】



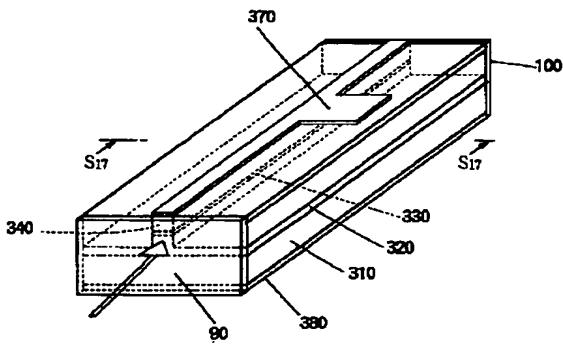
【図 14】



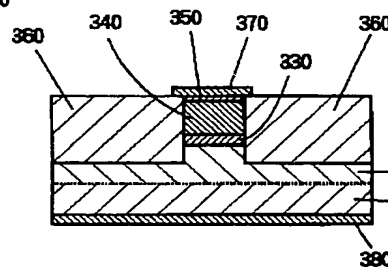
【図 15】



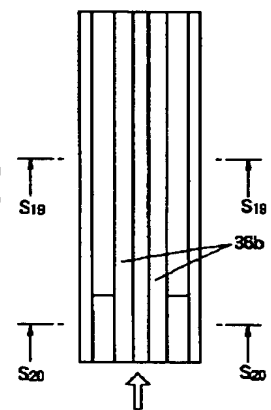
【図 16】



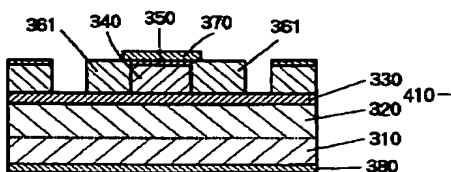
【図 17】



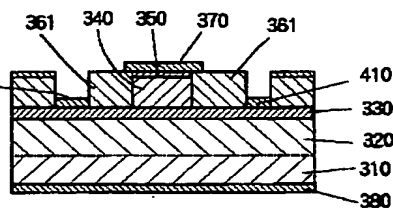
【図 18】



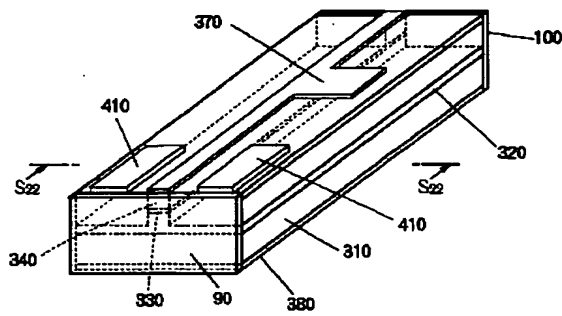
【図 19】



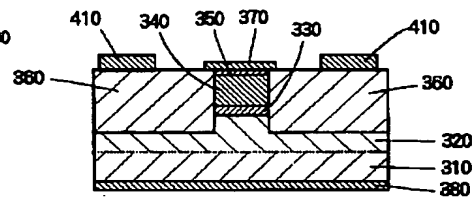
【図 20】



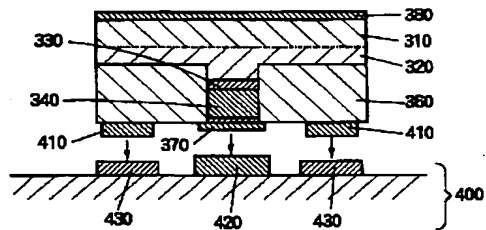
【図 2 1】



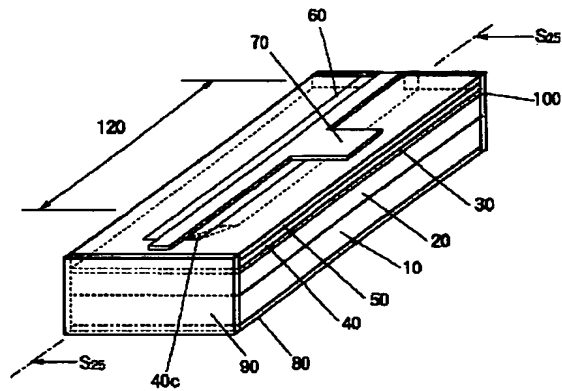
【図 2 2】



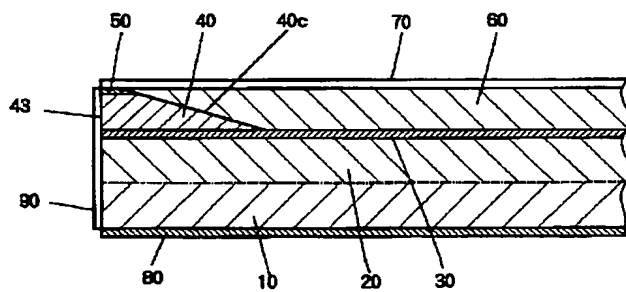
【図 2 3】



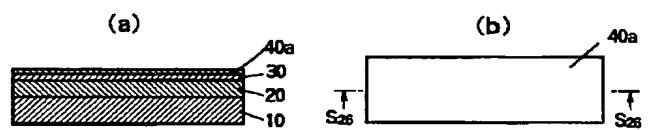
【図 2 4】



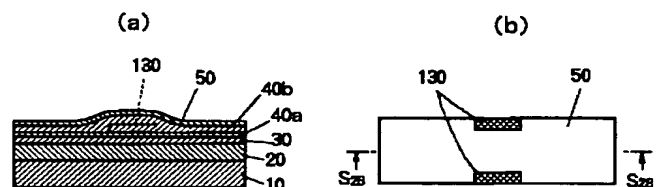
【図 2 5】



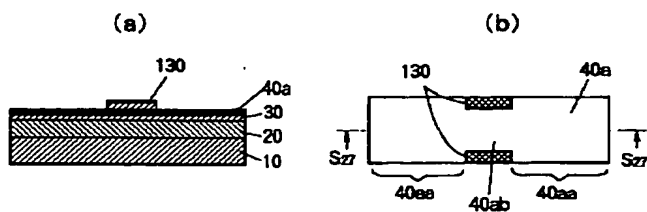
【図 2 6】



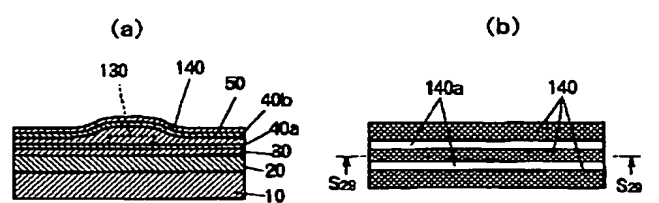
【図 2 8】



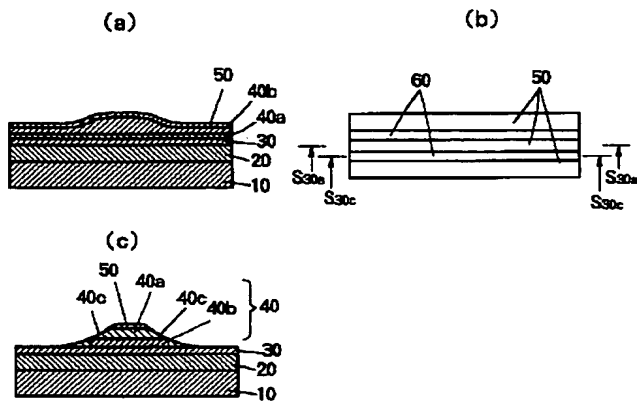
【図 2 7】



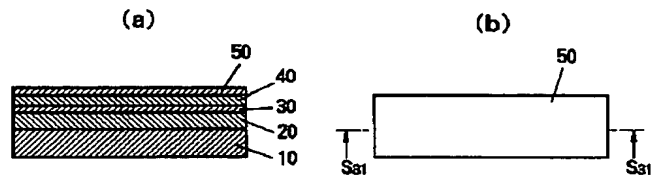
【図 2 9】



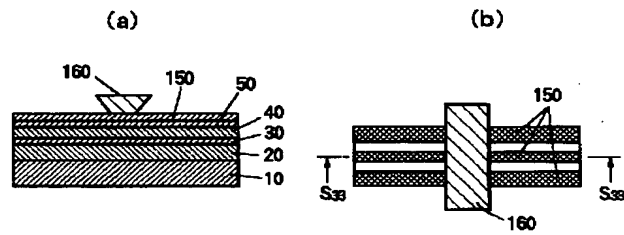
【図30】



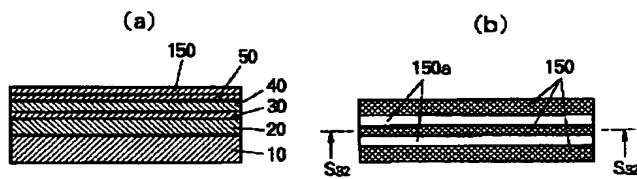
【図31】



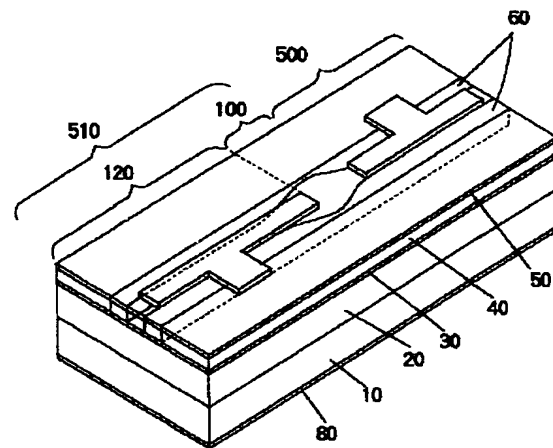
【図33】



【図32】



【図35】



【図34】

